2SB1046

シリコン PNP エピタキシャル形

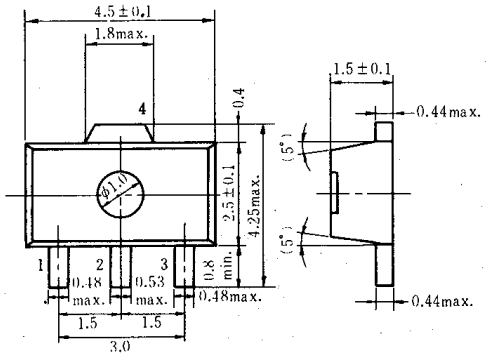
低周波電力増幅用

2SD1464とコンプリメンタリペア

SILICON PNP EPITAXIAL

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SD1464



1. ベース:Base
2. コレクタ:Collector
3. エミッタ:Emitter
4. コレクタ:Collector (フランジ) (Flange)

(Dimensions in mm)

(UPAK)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SB1046	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	−180	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	−160	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流	I_C	−50	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$*	−100	mA
許容コレクタ損失	P_C**	1	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	℃

＊パルス幅≦10ms, デューティサイクル≦20%

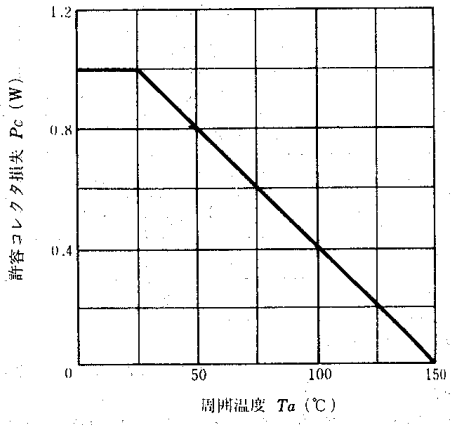
＊＊アルミナセラミック基板(12.5×20×0.7mm)使用時の許容値。

*PW≦10ms, Duty cycle ≦20%

**This value is allowed when using the alumina ceramic board (12.5×20×0.7mm).

許容コレクタ損失の周囲温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=−10μA, I_E=0	−180	−	−	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=−1mA, R_{BE}=∞	−160	−	−	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=−10μA, I_C=0	−5	−	−	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=−160V, I_E=0	−	−	−10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}*	V_{CE}=−5V, I_C=−10mA	60	−	320	
直流電流増幅率	h_{FE2}	V_{CE}=−5V, I_C=−1mA	30	−	−	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=−30mA, I_B=−3mA	−	−	−2	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=−5V, I_C=−10mA	−	−	−1.5	V
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=−10V, I_C=−10mA	−	140	−	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB}=−10V, I_E=0, f=1MHz	−	4.5	−	pF

＊2SB1046はh_{FE1}の値により下記のように2区分し、現品に表示してあります。

*The 2SB1046 is grouped by h_{FE1} as follows.

Mark	HH	HJ
h_{FE}	60～120	100～200

■ 各特性曲線は2SB648参照。

See characteristic curves of 2SB648.

HITACHI